

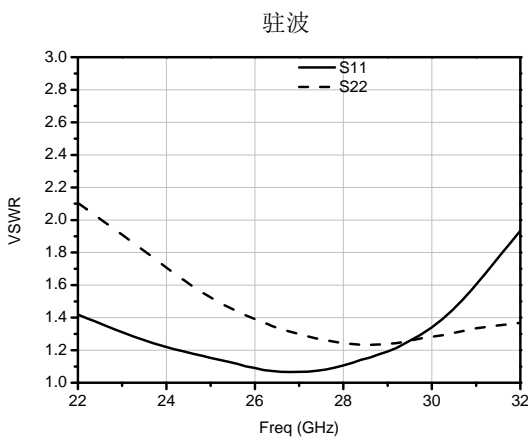
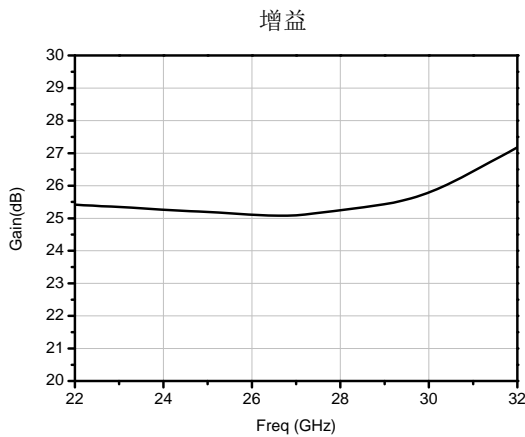
关键指标

频率: 22~32GHz
增益: 25.5dB
电压/电流: +3.5V/70mA
芯片尺寸: 1.8mm×0.95mm×0.1mm

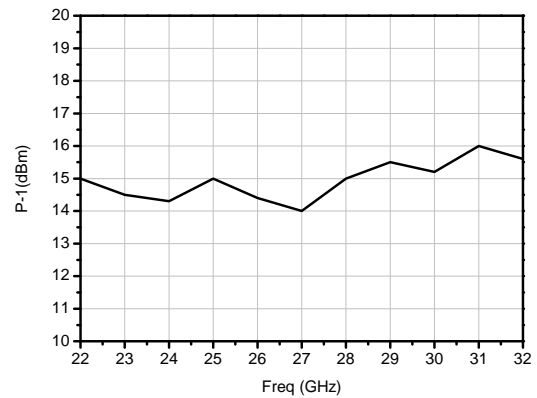
电性能 (T_A=25°C, V_{dd} = +3.5V, V_g=-0.6V)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	22~32		
增益(dB)	-	25.5	-
增益平坦度(dB)	-	±1	-
输入驻波	-	1.2	-
输出驻波	-	1.4	-
静态电流 (mA)	-	70	-

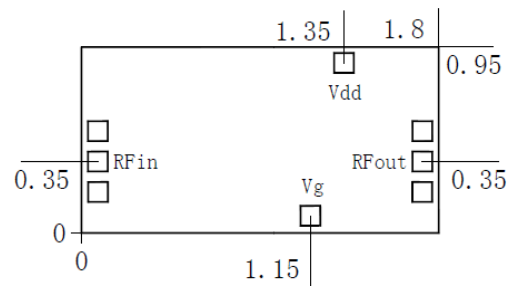
典型测试曲线



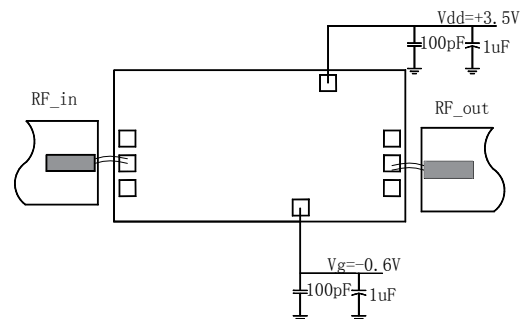
1dB 压缩点输出功率



外形和端口尺寸(mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+5.5V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55°C ~ 125°C
存储温度	-65°C ~ 150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。